

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第6部門第4区分  
【発行日】平成24年4月12日(2012.4.12)

【公開番号】特開2010-267326(P2010-267326A)  
【公開日】平成22年11月25日(2010.11.25)  
【年通号数】公開・登録公報2010-047  
【出願番号】特願2009-117504(P2009-117504)  
【国際特許分類】

G 1 1 C 16/02 (2006.01)

G 1 1 C 16/06 (2006.01)

【F I】

G 1 1 C 17/00 6 1 3

G 1 1 C 17/00 6 3 1

G 1 1 C 17/00 6 3 4 C

G 1 1 C 17/00 6 3 2 D

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月24日(2012.2.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

通常 of 読出動作を行なう第1 of 読出モードと、前記第1 of 読出モードよりも低消費電力で読出動作を行なう第2 of 読出モードとを有する不揮発性半導体記憶装置であって、

複数行複数列に配置された複数のメモリセルを含むメモリブロックと、

クロック信号の前縁に応答して、外部アドレス信号に従って前記複数のメモリセルのうち of のいずれか of のメモリセルを選択する選択回路と、

前記第1 of 読出モード時は、前記クロック信号の前縁に応答して前記選択回路によって選択されたメモリセルからデータを読み出し、前記第2 of 読出モード時は、前記クロック信号の後縁に応答して前記選択回路によって選択されたメモリセルからデータを読み出す読出回路とを備える、不揮発性半導体記憶装置。